

	<h2 style="color: red;">FCP22N60N-F102</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCP22N60N-F102
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 22A TO220-3
	Datenblätter:  FCP22N60N-F102.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	





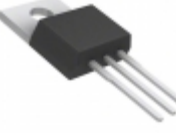
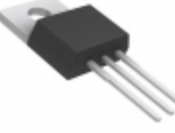

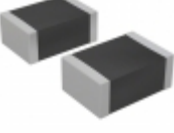
Spezifikationen

Teilenummer	FCP22N60N-F102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 22A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±45V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	165 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	205W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FCP22N60N_F102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1950pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 22A (Tc) 205W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Tc)

FCP22N60N-F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP22N60N-F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP22N60N-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCP22N60N-F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>FCP2416H124J Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.12UF 5% 50VDC 2416</p>	 <p>FCP2416H154G Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.15UF 2% 50VDC 2416</p>	 <p>FCP2416H124G Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.12UF 2% 50VDC 2416</p>	 <p>FCP22N60N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO-220</p>
 <p>FCP220N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 23A</p>	 <p>FCP22N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO-220</p>	 <p>FCP21N60N FSC FCP21N60N FSC</p>	 <p>FCP2416H124J-D1 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.12UF 5% 50VDC 2416</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP22N60N-F102 AMI Semiconductor	FCP22N60N-F102 Datenblatt	FCP22N60N-F102-Datenblätter	FCP22N60N-F102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FCP22N60N-F102 Electronic	FCP22N60N-F102-Komponenten	FCP22N60N-F102-Verteiler	FCP22N60N-F102-Bild	FCP22N60N-F102-Teil
FCP22N60N-F102 Preis	FCP22N60N-F102 Hersteller	FCP22N60N-F102 Bild	FCP22N60N-F102 Aktie	FCP22N60N-F102 Inventar
FCP22N60N-F102 Neu	FCP22N60N-F102 Original	FCP22N60N-F102 garantiert	FCP22N60N-F102 RFQ	FCP22N60N-F102 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited